



**PRIORITY DOCUMENT**  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1(a) OR (b)

REC'D 28 MAY 2003

WIPO PCT

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung  
einer Patentanmeldung**

**Aktenzeichen:** 102 16 786.9  
**Anmeldetag:** 15. April 2002  
**Anmelder/Inhaber:** ERS electronic GmbH, Germering/DE  
**Bezeichnung:** Verfahren und Vorrichtung zur Konditionierung  
von Halbleiterwafern und/oder Hybriden  
**IPC:** H 01 L 21/68

**Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur-  
sprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.**

München, den 08. Mai 2003  
Deutsches Patent- und Markenamt  
Der Präsident  
Im Auftrag

Dzlerzeit

P14104 SB/sb  
15.04.02 SB/sb

ERS ELECTRONIC GMBH, 82110 GERMERING

Verfahren und Vorrichtung zur Konditionierung von Halbleiterwafern und/oder Hybriden

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Konditionierung von Halbleiterwafern und/oder Hybriden.

Bekannterweise werden Testmessungen an Halbleiterwafern typischerweise in einem Temperaturbereich zwischen -200°C und +400°C durchgeführt. Zur Temperierung wird ein Halbleiterwafer auf einen Probertisch gelegt, der entsprechend der Soll-Temperatur gekühlt und/oder beheizt wird. Dabei ist darauf zu achten, dass die Temperatur des Halbleiterwafers nicht unter den Taupunkt des umgebenden gasförmigen Mediums gerät, da sonst eine Kondensation von Feuchtigkeit auf der Waferoberfläche bzw. eine Vereisung auftritt, welche die Testmessungen behindert bzw. unmöglich macht.

Fig. 5 zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer Konditionierungsvorrichtung zur Erläuterung der Problematik, welche der vorliegenden Erfindung zugrundeliegt.

In Fig. 4 bezeichnet Bezugssymbol 1 einen Raum in einem Behälter 5, in dem ein temperierbarer Probertisch 10 vorgesehen ist, auf den (nicht gezeigter) ein Halbleiterwafer zu

Testzwecken aufgelegt werden kann. Das Volumen des Behälters 5 liegt üblicherweise zwischen 400 und 800 Litern.

Der Raum 1 ist im wesentlichen durch die Wände des Behälters 5 geschlossen, welche Durchführungen für elektrische Leitungen und Medienversorgungsleitungen sowie ggfs. Durchführungen für extern anzubringende Sonden aufweisen, mit denen die Testmessungen gezeigten Halbleiterwafer durchzuführen sind. Der Raum 1 muss durch den Behälter 5 allerdings abhängig vom Anwendungsfall nicht hermetisch abgeschlossen sein, muss aber zumindest soweit geschlossen, dass ein ungewünschtes Eindringen von feuchter Umgebungsluft durch Aufbau eines inneren Überdrucks verhindert werden kann.

Der Probertisch 10 (auch Chuck genannt) weist eine thermische Isolation 15 auf, über die er mit einem üblicherweise beweglichen Fuss 20 verbunden ist. Ein entsprechender nicht gezeigter Bewegungsmechanismus weist in der Regel eine Verstellbarkeit in X-, Y- und Z-Richtung auf. Falls sich der Bewegungsmechanismus nicht in dem Behälter befindet, ist zwischen Fuss und Behälter eine Dichtung anzubringen.

Des weiteren ist in dem Probertisch 10 eine Heizeinrichtung 90 integriert, die von aussen mit elektrischem Strom zum Heizen versorgt werden kann und die eine nicht gezeigte Temperatursonde aufweist.

Bezugszeichen 100 bezeichnet einen Taupunktsensor, mittels dem der Taupunkt innerhalb des Behälters 5 ermittelbar ist und die ein entsprechendes Signal nach ausserhalb des Behälters 5 an einen Monitor 101 liefern kann. Der Taupunktsensor 100 dient insbesondere zur Sicherheit beim Öffnen des Geräts, damit z.B. ein Gegenheizen erfolgen kann, um eine Betauung zu vermeiden.

Weiterhin vorgesehen im Behälter sind Ausströmelemente 30 (oBdA. sind nur zwei gezeigt), über die von ausserhalb über eine Leitung r1 getrocknete Luft oder ein ähnliches Fluid, wie z.B. Stickstoff, in den Behälter eingeführt werden kann, um feuchte Umgebungsluft aus dem Behälter 5 auszutreiben. Diese Luft wird zunächst extern über eine Leitung r00 an einen Lufttrockner 3 zugeführt und dann in die Leitung r1 eingespeist.

Eine separate Einheit, welche mit dem Behälter 5 über eine entsprechende elektrische Leitungen 11 und eine Medienversorgungsleitung r2 verbunden ist, ist das Temperatursteuer- rack 2, welches folgende Einrichtungen aufweist.

Mit Bezugszeichen 80 ist ein Temperatur-Controller bezeichnet, der durch Beheizen der Heizeinrichtung 90 die Temperatur des Probertisches 10 regeln kann, wobei der Probertisch 10 gleichzeitig oder alternativ mit Luft zur Kühlung durchspülbar ist, wie unten näher erläutert wird.

Bezugszeichen 70 bezeichnet eine Temperierungseinrichtung, der über die Leitungen r0 und i1 trockene Luft z.B. aus einer Gasflasche oder auch aus einem Luftpumppfannen zugeführt wird und die einen Wärmetauscher 95 aufweist, der mit Kühlaggregaten 71, 72 verbunden ist, durch die er auf eine vorbestimmte Temperatur bringbar ist.

Die über die Leitungen r0, i1 zugeführte trockene Luft wird durch den Wärmetauscher 95 geleitet und anschliessend über die Versorgungsleitung r2 in den Behälter 5 zum Probettisch 10 geführt, den sie durch entsprechende nicht gezeigte Kühlslangen bzw. Kühlrohre durchquert. Über die Leitung r3 verlässt die trockene Luft, welche den Probettisch 10 gekühlt hat, denselben und wird aus dem Behälter 5 heraus an die Atmosphäre geleitet.

Üblicherweise wird die trockene Luft, welche zur Konditionierung der Atmosphäre in dem Behälter 5 über die Ausströmelemente 30 in den Behälter 1 geleitet wird, auf Raumtemperatur gehalten, so dass lediglich die Oberfläche des Probettisches 10 auf der gewünschten Messtemperatur, beispielsweise  $-20^{\circ}\text{C}$ , gehalten wird, die übrigen Elemente in dem Behälter 5 jedoch ungefähr auf Raumtemperatur sind. Aus dem Behälter 5 heraus strömt diese über die Ausströmelemente 30 zugeführte trockene Luft durch nicht gezeigte Ritzen bzw. Spalte oder eine separate Auslassleitung.

Als nachteilhaft bei dieser bekannten Vorrichtung zum Konditionieren von Halbleiterwafern hat sich die Tatsache her-

ausgestellt, dass ein relativ hoher Verbrauch an getrockneter Luft auftritt, da diese einerseits zum Konditionieren der Atmosphäre und andererseits zum Kühlen des Probertisches 10 durch den Behälter 5 an die Atmosphäre geblasen wird. Somit ist der Verbrauch an getrockneter Luft relativ hoch. Auch bewirkt ein Ausfall des Lufttrockners 3 ein sofortiges Vereisen des getesteten Wafers bei entsprechenden Temperaturen.

Daher ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Konditionierung von Halbleiterwafern und/oder Hybriden anzugeben, welche eine effizientere Konditionierung ermöglichen.

Das erfindungsgemäße Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 bzw. die entsprechende Vorrichtung nach Anspruch 9 weisen gegenüber dem bekannten Lösungsansatz den Vorteil auf, dass eine effiziente Ausnutzung des trockenen Gases möglich ist, beispielsweise der getrockneten Luft. Weitere Vorteile liegen in der hohen Betriebssicherung und in der Garantie der Eisfreiheit bzw. Kondensationsfreiheit, da die die Wafer/Hybrid-Aufnahmeeinrichtung verlassende trockene Luft stets unterhalb des Taupunktes der an der Wafer/Hybrid-Aufnahmeeinrichtung anliegenden Temperatur ist.

Die der vorliegenden Erfindung zugrundeliegende Idee besteht darin, dass zumindest ein Teil des die Wafer/Hybrid-Aufnahmeeinrichtung verlassenden Gases zum Konditionieren der Atmosphäre innerhalb des Raums verwendet wird. Bei der

vorliegenden Erfindung wird also Kühlluft gleichzeitig zu-  
mindest teilweise als Trockenluft verwendet. Es ist vor-  
teilhaft, wenn der Teil des Gases zunächst temperiert wird  
und dann innerhalb des Raums ausströmen gelassen wird.

Z.B. wird der Teil ausserhalb eines Behälters temperiert  
und dann dem Behälter wieder zugeführt. Ein besonderer Vor-  
teil dieses Beispiels liegt darin, dass eine höhere Kühleff-  
fizienz durch eine entsprechende Rückführung der Luft vom  
Probertisch nach ausserhalb des Behälters ermöglicht wird.  
Mit anderen Worten kann die rückgeführte gekühlte Luft zu-  
sätzlich entweder zur Vorkühlung der eingespeisten trocke-  
nen Luft oder zur Kühlung bestimmter Aggregate verwendet  
werden, und nicht nur zur Kühlung der Wafer/Hybrid-  
Aufnahmeeinrichtung.

Es ist aber auch alternativ oder zusätzlich möglich, dass  
ein Teil des Gases unmittelbar nach dem Verlassen des Pro-  
bertischs innerhalb des Behälters ausströmen gelassen wird.  
Da ein direktes Ausströmenlassen nicht bei allen Temperatu-  
ren zweckmässig ist, sollte ein entsprechendes Regulierven-  
til für diesen Teil des Gases vorgesehen sein.

In den Unteransprüchen finden sich vorteilhafte Weiterbil-  
dungen und Verbesserungen des betreffenden Gegenstandes der  
Erfindung.

Gemäss einer bevorzugten Weiterbildung weist die Leitungs-  
einrichtung eine erste Leitung, über die das Fluid von au-

sserhalb des Raums in die Wafer/Hybrid-Aufnahmeeinrichtung leitbar ist, eine zweite Leitung, über die das Fluid aus der Wafer/Hybrid-Aufnahmeeinrichtung nach ausserhalb des Raums leitbar ist, und eine dritte Leitung, über die das Fluid von ausserhalb des Raums in den Raum rückführbar ist, auf. Zwischen der zweiten und dritten Leitung ist eine Temperierungseinrichtung vorgesehen.

Gemäss einer weiteren bevorzugten Weiterbildung sind am Ende der dritten Leitung Ausströmelemente vorgesehen.

Gemäss einer weiteren bevorzugten Weiterbildung weist die Leitungseinrichtung eine erste Leitung, über die das Fluid von ausserhalb des Raums in die Wafer/Hybrid-Aufnahmeeinrichtung leitbar ist, und eine vierte Leitung, über die das Fluid aus der Wafer/Hybrid-Aufnahmeeinrichtung in den Raum leitbar ist, auf.

Gemäss einer weiteren bevorzugten Weiterbildung weist die Leitungseinrichtung eine zweite Leitung, über die das Fluid aus der Wafer/Hybrid-Aufnahmeeinrichtung nach ausserhalb des Raums leitbar ist, eine dritte Leitung, über die das Fluid von ausserhalb des Raums in den Raum rückführbar ist, auf. Zwischen der zweiten und dritten Leitung ist eine Temperierungseinrichtung vorgesehen.

Gemäss einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ist ein Ventil zum strömungsmengenmässigen Regulieren der vierten Leitung vorgesehen.

Gemäss einer weiteren bevorzugten Weiterbildung weist die Temperierungseinrichtung eine Heizeinrichtung aufweist.

Gemäss einer weiteren bevorzugten Weiterbildung weist die Temperierungseinrichtung einen Wärmetauscher auf, dem zumindest ein Teil des den Raum verlassenden Fluids zuleitbar ist.

Gemäss einer weiteren bevorzugten Weiterbildung dient der Wärmetauscher zum Vorkühlen des zugeführten Fluids.

Gemäss einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ist die Leitungseinrichtung derart gestaltet ist, dass der den Wärmetauscher verlassende Teil zumindest teilweise zum Konditionieren der Atmosphäre in den Raum rückführbar ist.

Gemäss einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ist eine weitere Leitung vorgesehen ist, über die zusätzlich trockenes Fluid direkt von ausserhalb des Raums in den Raum leitbar ist.

Gemäss einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ist der Raum durch einen Behälter im wesentlichen geschlossen.

Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert.

Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer ersten Ausführungsform der erfindungsgemässen Konditionierungsvorrichtung;

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer zweiten Ausführungsform der erfindungsgemässen Konditionierungsvorrichtung;

Fig. 3 eine schematische Querschnittsansicht einer dritten Ausführungsform der erfindungsgemässen Konditionierungsvorrichtung;

Fig. 4 eine schematische Querschnittsansicht einer vierten Ausführungsform der erfindungsgemässen Konditionierungsvorrichtung; und

Fig. 5 eine schematische Querschnittsansicht einer Konditionierungsvorrichtung zur Erläuterung der Problematik, welche der vorliegenden Erfindung zugrundeliegt.

In den Figuren bezeichnen gleiche Bezugszeichen gleiche oder funktionsgleiche Bestandteile.

Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung einer ersten Ausführungsform der erfindungsgemässen Konditionierungsvorrichtung.

Im folgenden werden zur Vermeidung von Wiederholungen Komponenten nicht erneut beschrieben, die bereits oben im Zusammenhang mit Fig. 5 beschrieben wurden..

Mit Bezugszeichen 80' ist ein modifizierter Temperatur-Controller bezeichnet, der nicht nur durch Beheizen der Heizeinrichtung 90 die Temperatur des Probertisches 10 regeln kann, sondern auch über eine Leitung 12 mit dem Taupunktsensor 100 gekoppelt ist und so ein automatisches Gegenheizen bei einer Betauungs-/ Vereisungsgefahr einleiten kann.

Bei der ersten Ausführungsform gemäss Fig. 1 ist in der Temperierungseinrichtung 70 zusätzlich eine Heizeinrichtung 105 integriert, welche nicht in direktem Kontakt mit dem Wärmetauscher 95 steht. Anstatt an der Umgebungsatmosphäre zu enden, ist die Leitung r3 zur Heizeinrichtung 105 geleitet, so dass die den Probertisch 10 verlassene trockene Luft gleichsam zum Temperatursteuerrack 2 zurückgeführt wird und nach Durchlaufen der Heinzeinrichtung 105 über die Leitung r4 wieder zum Behälter 5 geleitet, in dem sie durch Ausströmelemente 40 zum Konditionieren der Atmosphäre in dem Raum 1 ausströmt.

Bezugszeichen 4 bezeichnet einen Temperatursensor zur Erfassung der Temperatur im Raum 1, der ein entsprechendes Temperatursignal TS an die Temperierungseinrichtung 70 lie-

fert, welches zur Regelung der Temperatur mittels der Heiz-einrichtung 105 verwendet wird.

Durch diese Anordnung kann die getrocknete Luft eine Doppelfunktion erfüllen, nämlich zuerst die Kühlung des Probertisches 10 und danach die Konditionierung der Atmosphäre des Raums 1, bevor sie durch Öffnungen des Behälters 5 wieder an die Umgebungsatmosphäre geführt wird, und somit effektiver verwendet werden.

Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung einer zweiten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Konditionierungsvorrichtung.

Bei der zweiten Ausführungsform gemäss Fig. 2 zweigt von der Leitung r2 unmittelbar vor dem Probertisch 10 eine Leitung r5 ab, welche ebenfalls durch den Probertisch 10 in Form von einer Kühlschlange bzw. einem Kühlrohr geleitet wird, aber dann den Probertisch 10 an einer anderen Stelle verlässt als die Leitung r3 und von dort aus über ein steuerbares Auslassventil 45 die entsprechende getrocknete Luft direkt in den Behälter 5 nach dem Verlassen des Probertisches 10 leitet.

Da dies bei sehr tiefen Temperaturen bei bestimmten Anwendungen zu Problemen führen könnte, ist diese Option des Leitens des trockenen Gases über die Leitung r5 in den Behälter 1 durch das Auslassventil 45 regulierbar. Die Regu-

lierung kann in üblicher Weise, beispielsweise ferngesteuert oder drahtgesteuert, erfolgen.

Ansonsten ist die zweite Ausführungsform gleich aufgebaut wie die oben beschriebene erste Ausführungsform.

Fig. 3 zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer dritten Ausführungsform der erfindungsgemässen Konditionierungsvorrichtung.

Mit Bezugszeichen 80' ist ein weiter modifizierter Temperatur-Controller bezeichnet, der auch die Temperierungseinrichtung 70 über die Steuerleitung ST steuert und somit die Rolle einer Zentraltemperatursteuerung spielt.

Bei der dritten Ausführungsform gemäss Fig. 3 wird ein Teil der über die Leitung r3 zurückgeführten trockenen Luft vor der Heizeinrichtung 105 über eine Leitung i3 abgezweigt und durch den Wärmetauscher 95 geleitet, wo sie genau so wie die frisch über die Leitungen r0, i1 zugeführte trockene Luft zur Abkühlung beiträgt. Den Wärmetauscher 95 verlässt die trockene Luft über die Leitung i4 und wird unmittelbar hinter der Heizeinrichtung 105 mit der Luft zusammengeführt, welche durch die Heizeinrichtung 105 geflossen ist. Vom entsprechenden Knotenpunkt wird diese trockene Luft genau wie bei der ersten Ausführungsform über die Leitung r4 und die Ausströmelemente 40 in den Behälter 5 zur Konditionierung dessen Atmosphäre geleitet.

Weiterhin sieht diese Ausführungsform ein steuerbares Mischventil 46 und eine Bypassleitung r10 vor, durch die der Wärmetauscher 95 umgangen werden kann.

Der besondere Vorteil bei dieser Ausführungsform ist, dass eine „Restkälte“ der getrockneten Luft, welche vom Prober- tisch 10 zurückfliesst, zur Abkühlung des Wärmetauschers genutzt werden kann und gleichzeitig erwärmt in den Behäl- ter 5 zurückgeführt werden kann.

Ansonsten ist die zweite Ausführungsform gleich aufgebaut wie die oben beschriebene erste Ausführungsform.

Fig. 4 zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer vierten Ausführungsform der erfindungsgemässen Konditionie- rungsvorrichtung.

Bezugszeichen 85 In Fig. 4 bezeichnet einen zusätzlichen Gastemperatur-Controller, dem über Leitungen r0, i2 trockenes Gas, beispielsweise getrocknete Luft, von derselben Gasquelle wie derjenigen des Wärmetauschers 95 zugeführt wird, welche dieser auf eine vorbestimmte Temperatur bringt und dann über die Leitung r1 über die Ausströmelemente 30 in das Innere des Behälters 5 leitet.

Die direkte Zuführung getrockneter Luft über die Ausström- elemente 30 in den Behälter 5 ist bei dieser Ausführungs- form also noch zusätzlich vorgesehen, kann aber abschaltbar gestaltet werden, wenn die Durchflussmenge durch den Pro-

bertisch 10 vollständig zur Konditionierung der Atmosphäre innerhalb des Behälters 5 ausreicht.

Obwohl die vorliegende Erfindung vorstehend anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele beschrieben wurde, ist sie darauf nicht beschränkt, sondern auf vielfältige Weise modifizierbar.

Insbesondere sei darauf hingewiesen, dass die obigen Ausführungsbeispiele selbstverständlich miteinander kombinierbar sind. Auch können zusätzliche Leitungsverbindungen bzw. Regulierventile für die jeweilige Gasströmung vorgesehen werden, welche manuell oder elektrisch steuerbar sind.

Zudem lässt sich die Restkälte des rückgeführten Gases nicht nur zur Kühlung des Wärmetauschers 95 verwenden, sondern auch zur Kühlung beliebiger anderer Aggregate bzw. Wärmetauscher, bevor sie wieder dem Behälter 5 zugeführt wird.

Auch ist die Erfindung nicht auf gasförmige getrocknete Luft beschränkt, sondern prinzipiell auf beliebige Fluide anwendbar.

Weiterhin ist die Wafer/Hybrid-Aufnahmeeinrichtung nicht auf einen Probertisch bzw. Chuck beschränkt, sondern beliebig variierbar, z.B. als Klammereinrichtung o.ä.

ERS ELECTRONIC GMBH, 82110 GERMERING

Verfahren und Vorrichtung zur Konditionierung von Halbleiterwafern und/oder Hybriden

PATENTANSPRÜCHE

1. Verfahren zur Konditionierung von Halbleiterwafern und/oder Hybriden mit den Schritten:

Bereitstellen eines zumindest teilweise geschlossenen Raums (1) mit einer darin befindlichen Wafer/Hybrid-Aufnahmeeinrichtung (10) zur Aufnahme eines Halbleiterwafers und/oder Hybrids; und

Leiten eines trockenen Fluids durch die Wafer/Hybrid-Aufnahmeeinrichtung (10) zum Temperieren der Wafer/Hybrid-Aufnahmeeinrichtung (10);

wobei zumindest ein Teil des die Wafer/Hybrid-Aufnahmeeinrichtung (10) verlassenden Fluids zum Konditionieren der Atmosphäre innerhalb des Raums (1) verwendet wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Raum (1) durch einen Behälter (5) im wesentlichen geschlossen ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Teil zunächst temperiert wird und dann innerhalb des Raums (1) ausströmen gelassen wird.
4. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Teil ausserhalb des Raums (1) temperiert wird und dann dem Raum (1) wieder zugeführt wird.
5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Teil unmittelbar nach dem Verlassen der Wafer/ Hybrid-Aufnahmeeinrichtung (10) innerhalb des Raums (1) ausströmen gelassen wird.
6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein erster Teil des den Probertisch (10) verlassenden Fluids zunächst temperiert wird und dann innerhalb des Raums (1) ausströmen gelassen wird und ein zweiter Teil Teil unmittelbar nach dem Verlassen der Wafer/Hybrid-Aufnahmeeinrichtung (10) innerhalb des Raums (1) ausströmen gelassen wird.
7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest einer vom ersten und zweiten Teil strömungsmässig regulierbar ist.
8. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Teil dadurch temperiert wird, dass er zur Vorkühlung, insbesondere zur Vorkühlung des Fluids, ausserhalb

des Raums (1) verwendet wird, bevor er innerhalb des Raums (1) ausströmen gelassen wird.

9. Vorrichtung zur Konditionierung von Halbleiterwafern und/oder Hybriden mit:

einem zumindest teilweise geschlossenen Raum (1) mit einer darin befindlichen Wafer/Hybrid-Aufnahmeeinrichtung (10) zur Aufnahme eines Halbleiterwafers und/oder Hybrides; und

einer Leitungseinrichtung (r2, r3, r4, r5, i3, i4) zum Leiten eines trockenen Fluids durch die Wafer/Hybrid-Aufnahmeeinrichtung (10) zum Temperieren der Wafer/Hybrid-Aufnahmeeinrichtung (10) und zum Leiten zumindest ein Teil des die Wafer/Hybrid-Aufnahmeeinrichtung (10) verlassenden Fluids in den Raum (1) zum Konditionieren der Atmosphäre in dem Raum (1).

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Leitungseinrichtung (r2, r3, r4, r5, i3, i4) aufweist:

eine erste Leitung (r2), über die das Fluid von ausserhalb des Raums (1) in die Wafer/Hybrid-Aufnahmeeinrichtung (10) leitbar ist;

eine zweite Leitung (r3), über die das Fluid aus der Wafer/Hybrid-Aufnahmeeinrichtung (10) nach ausserhalb des Raums (1) leitbar ist; und

eine dritte Leitung (r4), über die das Fluid von ausserhalb des Raums (1) in den Raum (1) rückführbar ist;

wobei zwischen der zweiten und dritten Leitung (r3, r4) eine Temperierungseinrichtung (70; 70, 80'') vorgesehen ist.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass am Ende der dritten Leitung (r4) Ausströmelemente (40) vorgesehen sind.

12. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Leitungseinrichtung (r2, r3, r4, r5, i3, i4) aufweist:

eine erste Leitung (r2), über die das Fluid von ausserhalb des Raums (1) in die Wafer/Hybrid-Aufnahmeeinrichtung (10) leitbar ist; und

eine vierte Leitung (r5), über die das Fluid aus der Wafer/Hybrid-Aufnahmeeinrichtung (10) in den Raum (1) leitbar ist.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Leitungseinrichtung (r2, r3, r4, r5, i3, i4) aufweist:

eine zweite Leitung (r3), über die das Fluid aus der Wafer/Hybrid-Aufnahmeeinrichtung (10) nach ausserhalb des Raums (1) leitbar ist; und

eine dritte Leitung (r4), über die das Fluid von ausserhalb des Raums (1) in den Raum (1) rückführbar ist;

wobei zwischen der zweiten und dritten Leitung (r3, r4) eine Temperierungseinrichtung (70; 70, 80'') vorgesehen ist.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass ein Ventil (45) zum strömungsmengenmässigen Regulieren der vierten Leitung (r5) vorgesehen ist.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Temperierungseinrichtung (70; 70, 80'') eine Heizeinrichtung (105) aufweist.

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Temperierungseinrichtung (70; 70, 80'') einen Wärmetauscher (95) aufweist, dem zu mindest ein Teil des den Raum (1) verlassenden Fluids zu leitbar ist.

17. Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Wärmetauscher (95) zum Vorkühlen des zugeführten Fluids dient.

18. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Leitungseinrichtung (r2, r3, r4, r5, i3, i4) derart gestaltet ist, dass der den Wärmetauscher (95) verlassende Teil zumindest teilweise zum Konditionieren der Atmosphäre in den Raum rückführbar ist.

19. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass eine weitere Leitung (r1) vorgesehen ist, über die zusätzlich trockenes Fluid direkt von ausserhalb des Raums (1) in den Raum (1) leitbar ist.

20. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass der Raum (1) durch einen Behälter (5) im wesentlichen geschlossen ist.

ERS ELECTRONIC GMBH, 82110 GERMERING

Verfahren und Vorrichtung zur Konditionierung von Halbleiterwafern und/oder Hybriden

ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Erfindung schafft ein Verfahren zur Konditionierung von Halbleiterwafern und/oder Hybriden mit den Schritten: Bereitstellen eines zumindest teilweise geschlossenen Raums (1) mit einer darin befindlichen Wafer/Hybrid-Aufnahmeeinrichtung (10) zur Aufnahme eines Halbleiterwafers und/oder Hybrids; und Leiten eines trockenen Fluids durch die Wafer/Hybrid-Aufnahmeeinrichtung (10) zum Temperieren der Wafer/Hybrid-Aufnahmeeinrichtung (10); wobei zumindest ein Teil des die Wafer/Hybrid-Aufnahmeeinrichtung (10) verlassenden Fluids zum Konditionieren der Atmosphäre innerhalb des Raums (1) verwendet wird. Die Erfindung schafft auch eine entsprechende Vorrichtung zur Konditionierung von Halbleiterwafern und/oder Hybriden.

(Fig. 1)

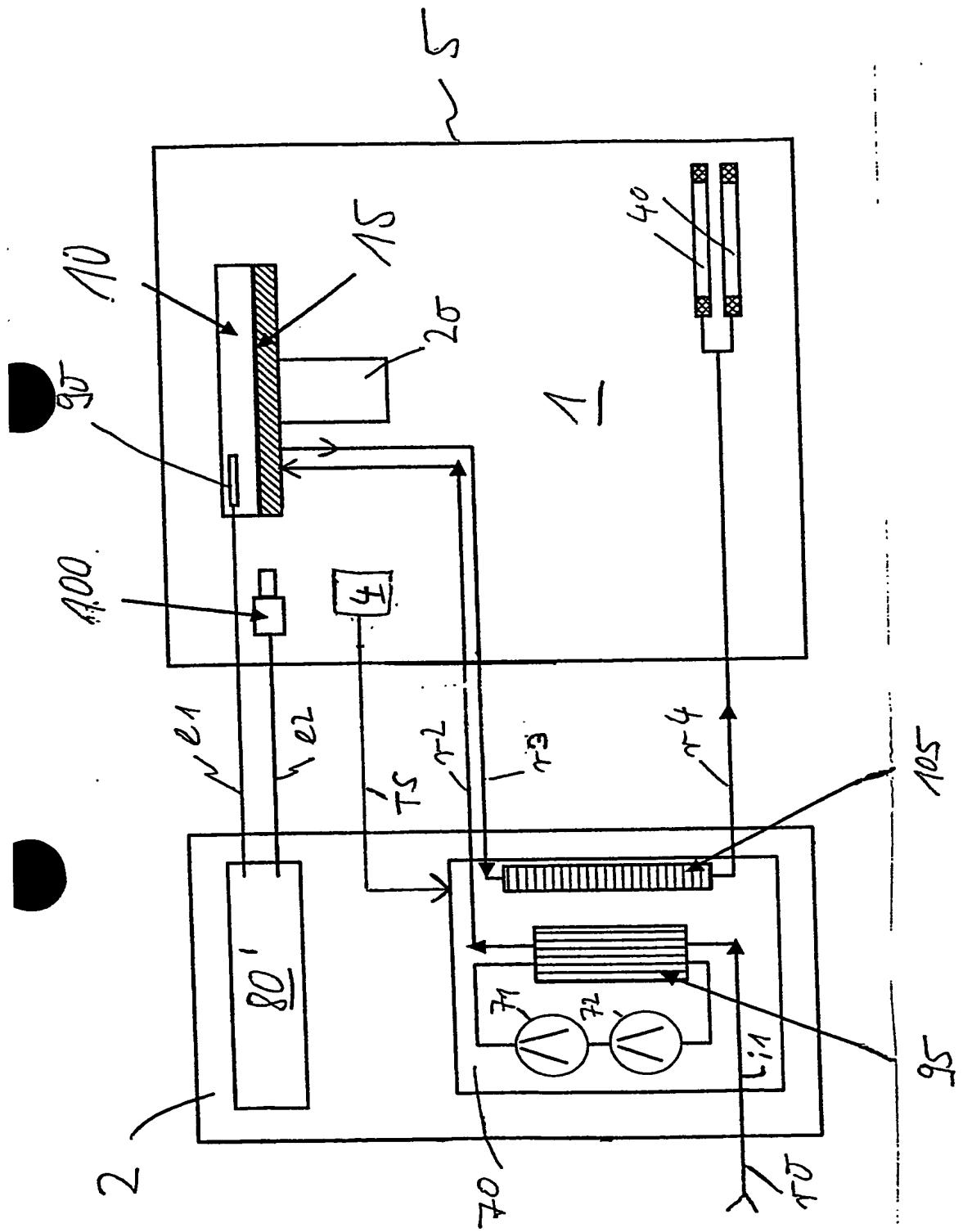


Fig. 1

11/5

Fig. 1

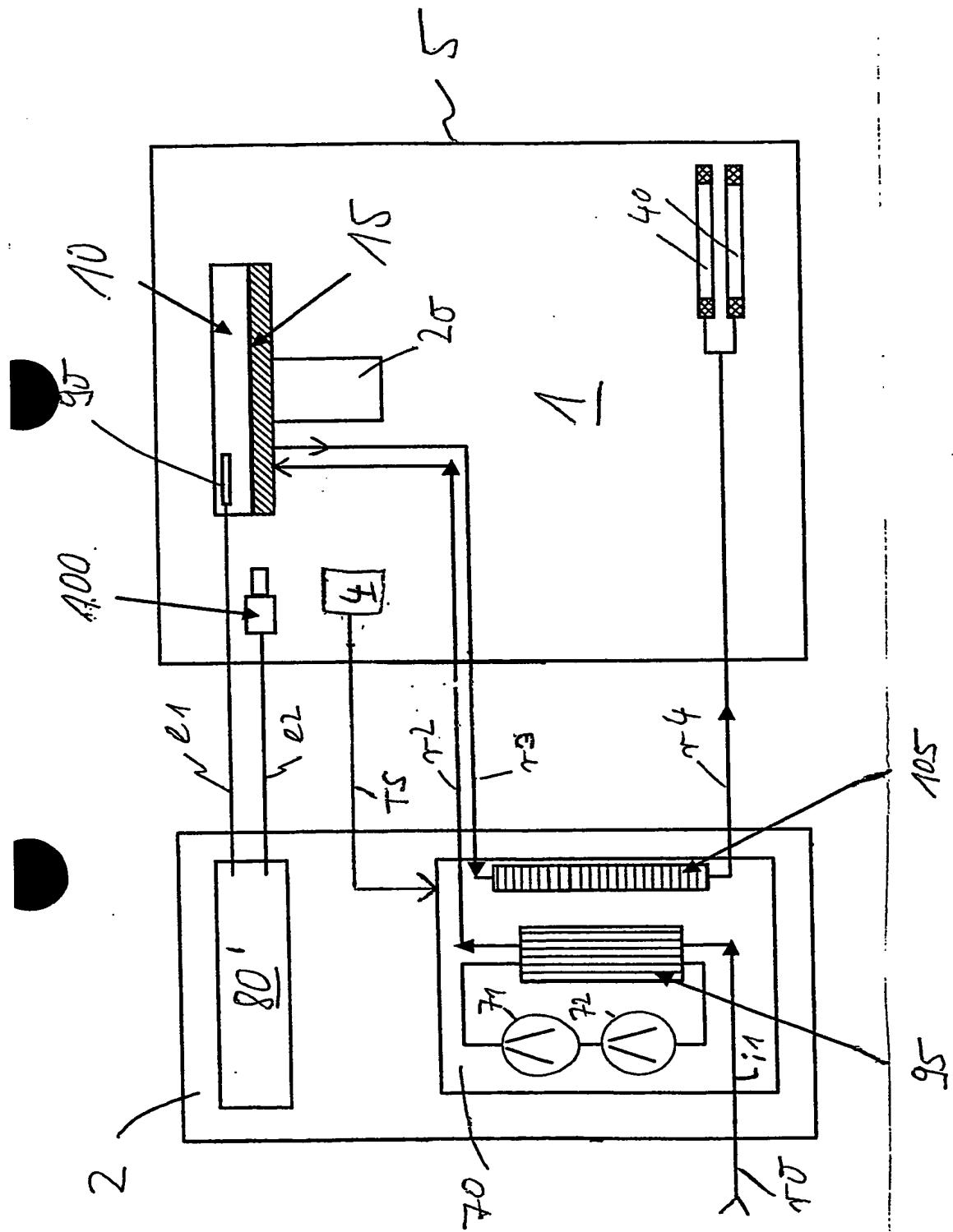
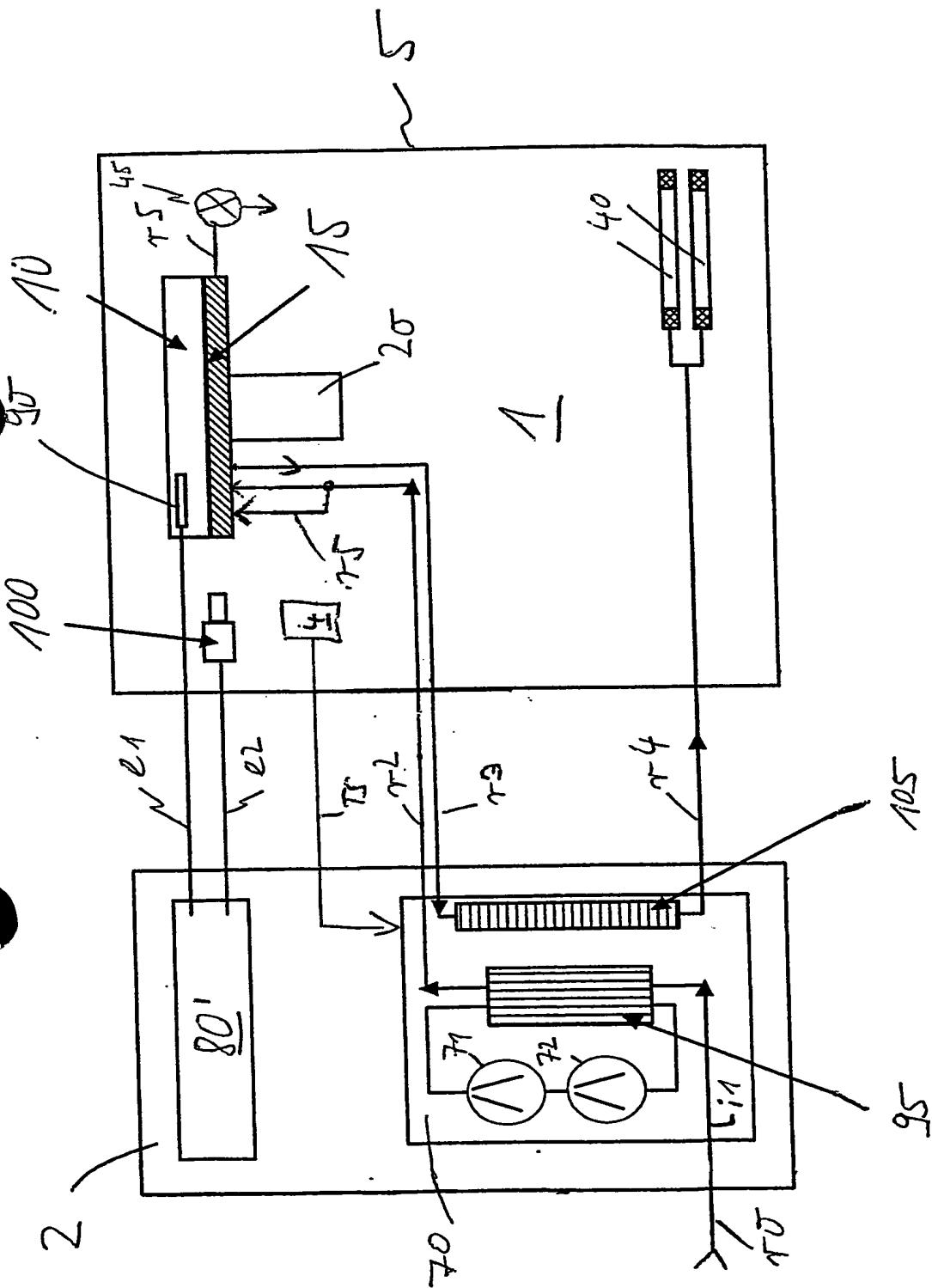
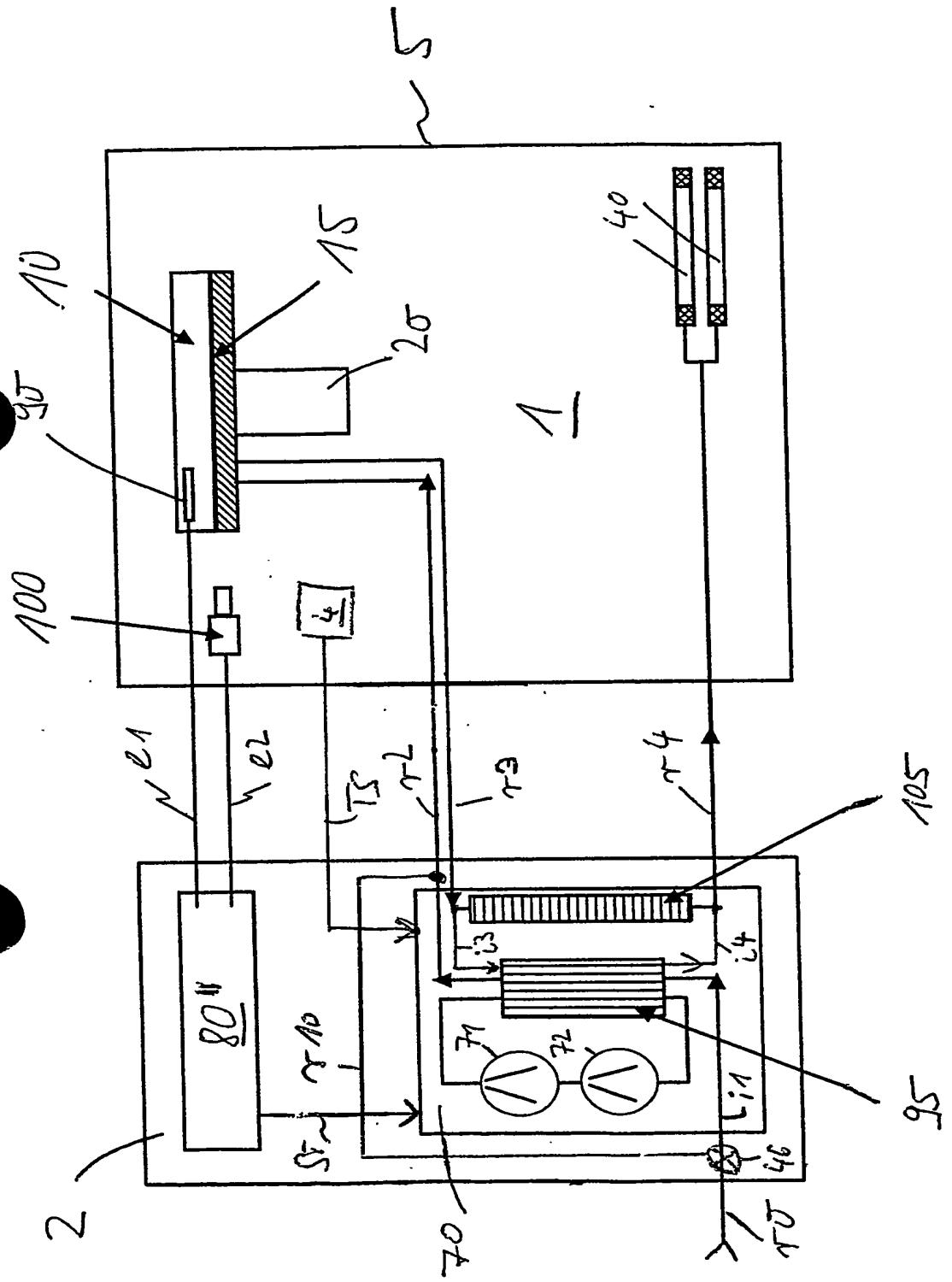


Fig. 2



53/5

Fig. 3



4/5

Fig. 4

